





# EXEMPLES DU RÔLE DE DIFFUSION CHIMIQUE DANS LES COUCHES MINCES À LA SURFACE DU VERRE PLAT

# **E.BUROV**

ECOLE SUFRACES ET INTREFACES DU VERRE, OLÉRON 2023

### LES RÉSULTATS DE 3 THÈSES



H. Montigaud



E. Gouillart

SAINT-GOBAIN



3 / Saint-Gobain confidential & proprietary

### **CONTEXTE INDUSTRIEL: FONCTIONNALISATION DE LA SURFACE**





### **CONTEXTE INDUSTRIEL: EXEMPLE**



### □ Mise en forme



**Bombage pare-brise** 

### Optimisation des propriétés mécaniques



#### Trempe thermique

### Activation des propriétés des couches minces

6 / Saint-Gobain confidential & proprietary

Empilement de couches minces à base d'argent déposées sur verre

Dieleerique

# Ag ZnO

Dielectrique

Verre

## 550°C - 700°C 2-10min





### □ Activation des propriétés des couches minces



□ Activation des propriétés des couches minces



→ Improved photocatalytic activity

### □ Activation des propriétés des couches minces



**×** Alkali diffusion **→ ×** Alteration of the thin films properties

### **POST-TRAITEMENTS THERMIQUES: DIFFUSION**









### ECOLE THEMATIQUE DU CNRS

### « Verres et diffusion » Diffusion chimique dans les phases vitreuses et liquides

03 au 08 octobre 2021 - La Villa Clythia Fréjus

https://www.ustverre.fr/site/index.php?option=com\_content&view=article&id=402&Itemid=966&Iang=fr



### Ecole sur la diffusion dans les solides

20 au 34 avril 2020, Marseille 26 au 30 avril 2021, Marseille



Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence





Couple SiQ., B.O. Couple Na.O-8.O

Alteration

laver

4 6 Depth (µm)

C/Si+

Normalized

Pristine

glass





#### COMMENT CARACTÉRISER LA DIFFUSION DANS LES COUCHES MINCES? SGR Paris: Thierry Cretin, Hervé Montigaud Time-of-Flight Secondary Ion Mass spectroscopy (ToF-SIMS) Analyseur à temps de vol (Tof) Principe Profils des ions secondaires Analyse simultanée de tous les plr: 550°C @ 0 min éléments (ions secondaires) Source de décapage 106 Source d'analyse Sensibilité ~ gg ppm (Bi+) $(Cs^+, O_2^+)$ Ions secondaires, neutres, 10 clusters $(M^0, M+, CsM+) + e^{-1}$ Intensité (coups) 104 Effets de matrice 10

10

200



P Calibration vitesse de décapage

800

600 temps décapage

G2 **Détermination** des facteurs de sensibilités = mesures quantitatives

1000

1200

Ba+



### **COMMENT CARACTÉRISER LA DIFFUSION DANS LES COUCHES MINCES?**

Vers les mesures quantitatives

SGR Paris: Thierry Cretin, Hervé Montigaud

Profils des ions secondaires



Pic de l'étain = témoin de la surface du verre

Calibration vitesse de décapage







14 / Saint-Gobain confidential & proprietary

### **COMMENT CARACTÉRISER LA DIFFUSION DANS LES COUCHES MINCES?**

SGR Paris: Thierry Cretin, Hervé Montigaud

- Vers les mesures quantitatives
- ✤ Détermination des facteurs de sensibilités = mesures quantitatives
  - Utilisation du substrat comme étalon
  - Validation par XPS et EPMA et l'analyse de la composition du verre





PhD: J.-T. Fonné



**Figure 24 :** Profils SIMS de Na<sub>2</sub>O pour des couches de silice de 150 nm d'épaisseur dopées  $Al_2O_3$  (4% masse), en fonction du temps de recuit et de la température : A - recuit 550°C, B - recuit 600°C, C - recuit 650°C.

- Concentration de Na augmente avec T pour le même temps
   Na augment avec la temps integui en plateau
- ✓ Na augment avec le temps jusqu' au plateau



PhD: J.-T. Fonné



Diffusion Na et K 🛪 lorsque Al 🛪 ??



PhD: S. Ben Khemis

SAIN

Equilibrium of alkali concentration: 650°C\_60 min

Glass + 150 nm SiO<sub>2</sub>:Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0.2=>28 %wt), 2 µbar

#### **Depth profile of Na**



→ Aluminum doping of the film enhances the alkali diffusion





SAIN

# DIFFUSION: SUBSTRAT VERRE /COUCHE AMORPHE<sub>PhD: S. Ben Khemis</sub>



 RMN a mis en évidence que 89 % des atomes d'Al se trouvent en coordinence 4.

Effet de recuit à 650 °C	H <sub>Surface</sub> (10 <sup>15</sup> at/cm²)	H <sub>Couche</sub> silice (% atomique)
Non recuit	$16 \pm 1$	$1.7\pm0.1$
Recuit 5 min	$13 \pm 1$	$1\pm0.08$
Recuit 15 min	$15 \pm 1$	$0.2\pm0.02$

ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis)

✓ Na<sup>+</sup> est compensateur de charge



PhD: J.-T. Fonné



PhD: S. Ben Khemis



 Na<sup>+</sup> est compensateur et modificateur de charge



Retour à la thermodynamique … mais avec de l'eau :

Pour 6000 ppm d'eau dans la silice







PhD: J.-T. Fonné

Retour à la thermodynamique … mais avec de l'eau :

Pour 6000 ppm d'eau dans la silice





PhD: J.-T. Fonné

IMPACT DE LA PRESSION DU DÉPÔT

PhD: S. Ben Khemis



 Une diminution de la densité macroscopique de la couche est liée à l'augmentation de porosité interconnectée





Modification des propriétés de la couche avec la diffusion de Na+ :

#### SiO<sub>2</sub> dopée 2,4 % (mol) Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 1200 Na<sup>+</sup> modificateurs de réseau 1100 1000 (°c) 900 ല 800 700 Na<sup>+</sup> compensateurs de charges 600 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 0 1 2 3 4 Na<sub>2</sub>O (% mol)

# Evolution de la Tg de SiO<sub>2</sub> dopée 2,4% $AI_2O_3$ au fur et à mesure de la diffusion du sodium



Evolution de la viscosité de SiO<sub>2</sub> pour un ratio

► Tg de la couche diminue => mobilité des ions augmente



Décalage de l'interface silice/verre au cours du temps : couches silice – épaisseur 150nm – recuit 650°C

Silice dopées 4% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (wt %)

Silice pure







$$D = D_a \exp\left[\beta \left\{C - \frac{1}{2} \left(C_1 + C_2\right)\right\}\right] \qquad \beta = \frac{1}{C_1 - C_2} \ln\left(\frac{\eta_2}{\eta_1}\right)$$
$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D(C)\frac{\partial C}{\partial x}\right)$$





SAIN







LO reflète la présence de lacunes d'oxygène E<sub>2</sub><sup>high</sup> montre la présence d'un désordre local important

Liu et al., Ferroelectrics, 1999



PhD: S. Ben Khemis



### Annealing effect (≤ 10 min):

- Intensity inversion of intensity  $E_2^{high}$  and  $A_1(LO)$  peaks
- Increase in ratio intensity  $E_2^{high}/A_1(LO)$
- → Crystallinity improvement of AZO film



### Annealing effect (> 25 min):

- Reduction of the E2high / A1 (LO) ratio
- →Degradation of crystalline quality of AZO



# DIFFUSION: SUBSTRAT VERRE /COUCHE OXYDE PhD: S. Ben Khemis



PhD: S. Ben Khemis





AZO

**PLC** 













SAINT-GOBAIN

# Recuit sous vide (300-600°C, 1h)

#### **Evolution des microstructures**



SAINT-GOBAIN

### Recuit sous vide (300-600°C, 1h)

Profils 1D de diffusion du nickel





T > 400°C : diffusion du nickel dans ZnO

• 450°C < T < 500°C : saut significatif

T = 600°C : épaulement à l'interface



#### DIFFUSION: COUCHE OXYDE/COUCHE MÉTALLIQUE [Jacques Perrin Toinin]

Recuit sous vide (300-600°C, 1h)

Localisation du Ni par sonde atomique tomographique (APT)



(c) Reconstruction 3D

0 0 [Ni] (%at.) (%at.)

(d) Projection 2D des concentrations



**RNTHAACHEN** UNIVERSITY

1%

(a) Pointe APT usinée par FIB

Cas du recuit à 400°C

### -Recuit sous vide (300-600°C, 1h)

Localisation du Ni

### (A) Bosse @550°C proche de la surface

Profils ToF-SIMS du nickel







 Régions enrichies en nickel (2.10<sup>-1</sup> <[Ni] %<sub>at.</sub>< 4)</li>



[Jacques Perrin Toinin]

#### **RWITHAACHEN** UNIVERSITY

Localisation du Ni

Recuit sous vide (300-600°C, 1h)

(B) Plateau @600°C

APT dans le volume

(C) Epaulement à l'interface @600°C





- 55





#### Evolution de l'empilement en température



SAINT-G

Rappel : diffusion dans un polycristal



#### Lois d'Arrhenius types

[D. Gupta, (1988)]

Dsurface > Djg >> Dg

Court-circuit de diffusion

### Régimes cinétiques d'Harrison



(Dt)<sup>1/2</sup> >> d

555







- T > 450°C : Pas d'impact des conditions de dépôt dans G
- Recuit sous air limite la diffusion dans G

- A matrice fixée (ZnO) : diffusion dans JG dépend de la forme du Ni
- A source fixée (NiO) :
  - diffusion plus lente dans JG pour ZnO + O<sub>2</sub>
  - Diffusion sous vide équivalente à sous air



### **POST-TRAITEMENTS THERMIQUES: DIFFUSION**





49 / Saint-Gobain confidential & proprietary





## MERCI POUR VOTRE ATTENTION





# MERCI POUR VOTRE ATTENTION



#### Introduction

Conclusions et Perspectives

### Couches bloqueurs : intérêt



#### Oxydation de la couche d'Ag :



#### Avec le dépôt de ZnO

[R. J. Martin-Palma and al., J. of V. S. & Tech. (1999)]

#### Avec les recuits

[M. T. Rahman, J.P. Chemistry, (2017)] [S. Petrovic, Science of Sintering (2006)]









#### Saint-Gobain confidential & proprietary 52 /

[M. Philipp, Thèse de doctorat (2011)]

#### Introduction

#### Diffusion

Conclusions et Perspectives

### Couches bloqueurs : intérêt



#### Oxydation de la couche d'Ag :



[R. J. Martin-Palma and al., J. of V. S. & Tech. (1999)]

#### 

[M. T. Rahman, J.P. Chemistry, (2017)] [S. Petrovic, Science of Sintering (2006)]



Métaux de transition avides d'oxygène (effet « getter »)

Ti, NiCr

SAINT-GOBAIN

Couche sacrificielle pour éviter l'oxydation de l'Ag

CIII

(2017)]

[E. Chernysheva, Thèse de doctora

 $\frac{\text{Métal}}{\Delta H_f^0} = 0 \text{ à } -50 -200 \text{ à } -250 -350 \text{ à } -400 -500 \text{ à } -550}$ (kJ par mole d'O)
(kJ par mole d'O)
(kJ par mole d'O)

[C. T. Campbell, S. science (1997)]

53 / Saint-Gobain confidential & proprietary

#### roduction

# NiCr/ZnO

sion

SAIN

SAINT-GOBAIN

# Recuit sous air (650°C, 8 min)

#### Evolution de la répartition des espèces



Le Ni diffuse dans tout le ZnO Le Cr diffuse peu (localisé à l'interface)

Avant recuit STEM-EDX (en coupe) Zn 0 Ni Cr 10 nm Après recuit Zn Ni 0 Cr 10 nm CNrs Formation de précipités riches en Ni À l'interface NiCr /ZnO



A retenir ...

# Empliement NiCr/ZnO





SAIN

SAINT-GOBAIN

#### Evolution de l'empilement en température



Pas (peu) de diffusion du Cr

#### Introduction

### Paramètres de dép Diffusion

#### Conclusions et Perspectives

SAINT-GOBAIN

### <sup>1</sup><sub>j</sub><sup>1</sup> <u>Ajout d'oxygène au cours du dépôt</u>



### Paramètres de dép Diffusion

Conclusions et Perspectives

Scans XPS haute résolution

### $i_{j}i_{j} = Au niveau de la couche de NiCr$







### Paramètres de dé Diffusion

Conclusions et Perspectives

<sup>1</sup><sup>1</sup><sup>1</sup> Empilements : microstructures du ZnO ?



	NiCr/ZnO	NiCrOx/ZnO	NiCr/ZnO+O2
Texturation (%)	95	87	100
Diamètre (nm)	32	26	26
Epsilon	9.10 <sup>-3</sup>	7.10-3	9.10 <sup>-3</sup>



58 / Saint-Gobain confidential & proprietary

#### Introduction

### Paramètres de dép Diffusion



### <sup>‡</sup>j<sup>‡</sup>‡ <u>Empilements</u> : état d'oxydation de NiCr à l'interface ?

XPS haute résolution à l'interface



Diagramme de Wagner : espèces majoritaires du Ni



ZnO → faibles modifications, formation d'hydroxy

ZnO + O<sub>2</sub>  $\rightarrow$  modifications importantes, formation

59 / Saint-Gobain confidential & proprietary

[M. Biesinger, Phys. Chem. Chem. Phys., 28 AINT-GOBAIN

#### ntroduction

#### Diffusion

Conclusions et Perspectives

# Recuit sous vide : effet de l'oxygène intrinsèque



#### Introduction

#### Diffusion

Conclusions et Perspectives

# <u>Décorrélation : état d'oxydation du Ni et nature du ZnO</u>



ntroduction

Diffusion

Conclusions et Perspectives

# Recuit sous air : effet de l'oxygène extrinsèque





Hypothèse : homogénéisation par l'apport extérieur d'oxygène



62 / Saint-Gobain confidential & proprietary



- A source fixée (NiO) :
  - diffusion plus lente dans JG pour ZnO + O<sub>2</sub>

CNIS

SAIN

SAINT-GOBAIN

Diffusion sous vide équivalente à sous air



dans G

#### Introduction



Effets de l'apport d'oxygène sur la diffusion du Ni



A retenir ...

#### Au cours du dépôt de la couche de NiCr

- Dans le grain (G) :
- $T < 450^{\circ}C : Dg(Ni) < Dg(Ni(OH)x, NiO)$
- T > 450°C : Diffusion similaire (  $\rightarrow$  NiO)
- Dans le joint de grain (GB) : Amplitude dépend de la forme de départ (Ni, Ni(OH)x, NiO)

#### Au cours du dépôt de la couche de ZnO

Diffusion dans les GBs plus lente

#### Par le recuit

Diffusion similaire quelles que soient les systèmes étudiés



# <u>Diffusion dans les o</u>xydes

#### Défauts intrinsèques

<u>Défaut</u>	Eb (eV)	<u>T (K</u> )
$Zn_i^{2+}$	0.57	219
$V_{Zn}^{2-}$	1.4	539
$V_{O}^{0}$	1.7	655
$O^{(split)}$	2.36	909
$O_i$	0.87	335
$O_i^{(oll)}$	1.14	439

[X. Wang and al., Science 316 (2007)]

#### Zones de charges



Figure 1 The proposed atomic defect model for Schottky barrier at the grain boundary. Also shown is the analogy with band model.

Effets de taille



Fig. 34.9. Defect concentration profiles in nanostructures of ionic materials with dimension d.  $L_D$  is the Debye screening length

